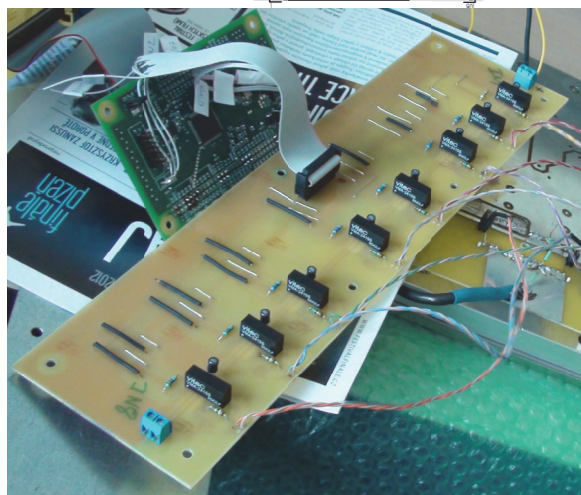
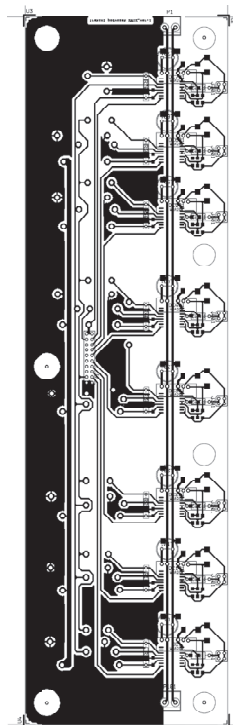


Funkční vzorek

Budící obvody s desaturační ochranou a impedančním přizpůsobením řídicích signálů pro 8 MOSFET tranzistorů



- ✓ V souladu s definicí uvedenou v dokumentu Úřadu vlády ČR, č.j.: 6951/2012-RVV „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012)“ je uplatňován funkční vzorek „Budící obvody s desaturační ochranou a impedančním přizpůsobením řídicích signálů pro 8 MOSFET tranzistorů“.
- ✓ Funkční vzorek vznikl v přímé souvislosti s řešením projektu VHČ – zak. č. 22 9038.
- ✓ Inteligentní driver pro buzení osmice CMOS tranzistorů v diskretním provedení se z hlediska funkčnosti dělí na následující části: vstupní část pro impedanční přizpůsobení s řídicí jednotkou, výkonový (budící) stupeň a galvanicky oddělené zdroje. Driver je použit pro napájení 2 H-můstků složených z MOSFET tranzistorů a z důvodu funkčnosti je proto nutné mít galvanicky oddělené zdroje pro spodní a horní tranzistory.
- ✓ Systém je navržen tak, aby splňoval následující parametry: galvanické oddělení výkonové a řídicí části $U_{isol}=2,5kV$ (včetně zpětných chybových hlášení), spínací frekvence 1-100kHz, ochrana výkonové součástky proti zkratu pomocí Desaturační ochrany.

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

22160-FV009-2012

KONTAKTNÍ OSOBA:

Doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D.

tel.: 377634437

drabek@kev.zcu.cz

ŘEŠITELSKÉ

PRACOVNÍŠTĚ:

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická

Katedra elektromechaniky

a výkonové elektroniky

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň